**Features:**

Volle Sperrfähigkeit bei 125° mit 50 Hz

Full blocking capability at 125°C with 50 Hz

Hohe Stoßströme und niedriger Wärme-
widerstände durch NTV-Verbindung
zwischen Silizium und Mo-Trägerscheibe.High surge currents and low thermal resistance
by using low temperature-connection NTV between
silicon wafer and molybdenum.

Elektroaktive Passivierung durch a - C:H

Electroactive passivation by a - C:H

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Vorwärts - und Rückwärts-Spitzensperrspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltage	f = 50 Hz	V_{DRM} , V_{RRM}	$t_{vj} = -40^{\circ}\text{C}.. 0^{\circ}\text{C}... t_{vj\text{ max}}$ 6000 6200 6500 6700 7000 7200	V V V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert RMS forward current		I_{TRMSM}	510	A
Dauergrenzstrom mean forward current	$t_C = 85^{\circ}\text{C}$, f = 50Hz $t_C = 60^{\circ}\text{C}$, f = 50Hz	I_{TAVM}	245 325	A A
Stoßstrom-Grenzwert surge forward current	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $t_p = 10\text{ms}$, $V_R = 0$ $t_{vj} = t_{vj\text{ max}}$, $t_p = 10\text{ms}$, $V_R = 0$	I_{TSM}	4,7 4,2	kA kA
Grenzlastintegral I^2t -value	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $t_p = 10\text{ms}$ $t_{vj} = t_{vj\text{ max}}$, $t_p = 10\text{ms}$	I^2t	$110,5 \cdot 10^3$ $88,2 \cdot 10^3$	A^2s A^2s
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 747-6 f = 50Hz, $V_D = 0,67 V_{DRM}$ $i_{GM} = 3\text{A}$, $di_G/dt = 6\text{A}/\mu\text{s}$	$(di/dt)_{cr}$	300	A/ μs
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state current	$t_{vj} = t_{vj\text{ max}}$, $V_D = 0,67 V_{DRM}$ 5. Kennbuchstabe / 5 th letter H	$(dv/dt)_{cr}$	2000	V/ μs



Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlaßspannung on-state voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}, i_T = 500A$	V_T	typ. 3,25	Max. 3,40	V
Schleusenspannung / threshold voltage Ersatzwiderstand / slope resistance	$t_{vj} = t_{vj\ max}$ (200A / 600A)	$V_{(TO)}$ r_T	typ. 1,24 3,97	Max. 1,29 4,18	V mΩ
Durchlaßrechenkennlinien On - state characteristics for calculation $V_T = A + B \cdot i_T + C \cdot \ln(i_T + 1) + D \cdot \sqrt{i_T}$ 100 A ≤ i_T ≤ 1000 A	$t_{vj} = t_{vj\ max}$	A B C D	typ. 0,02009 0,002673 0,2013 0,02874	Max. -0,4570 0,003951 0,4384 -0,03762	
Zündstrom gate trigger current	$t_{vj} = 25^\circ C, V_D = 6V$	I_{GT}		350	mA
Zündspannung gate trigger voltage	$t_{vj} = 25^\circ C, V_D = 6V$	V_{GT}		2,5	V
Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current	$t_{vj} = t_{vj\ max}, V_D = 6V$ $t_{vj} = t_{vj\ max}, V_D = 0,5 V_{DRM}$	I_{GD}		20 10	mA mA
nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage	$t_{vj} = 25^\circ C, V_D = 0,5 V_{DRM}$	V_{GD}		0,4	V
Haltestrom holding current	$t_{vj} = 25^\circ C, V_D = 12V, R_A = 4,7\Omega$	I_H		350	mA
Einraststrom latching current	$t_{vj} = 25^\circ C, V_D = 12V, R_{GK} \geq 10\Omega$ $i_{GM} = 3A, di_G/dt = 6 A/\mu s, t_g = 20\mu s$	I_L		3	A
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse currents	$t_{vj} = t_{vj\ max}$ $V_D = V_{DRM}, V_R = V_{RRM}$	i_D, i_R		100	mA
Zündverzug gate controlled delay time	DIN IEC 747-6 $t_{vj} = 25^\circ C,$ $i_{GM} = 3A, di_G/dt = 6A/\mu s$	t_{gd}		2,5	μs
Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time	$t_{vj} = t_{vj\ max}, I_{TM} = I_{TAVM}$ $V_{RM} = 100V, V_{DM} = 0,67 V_{DRM}$ $dv_D/dt = 20V/\mu s, -di_T/dt = 10A/\mu s$ 4. Kennbuchstabe / 4 th letter O	t_q	typ.	600	μs
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$t_{vj} = t_{vj\ max}$ $I_{TM} = 500 A, di/dt = 10 A/\mu s$ $V_R = 0,5 V_{RRM}, V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$	Q_r		3,5	mAs
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$t_{vj} = t_{vj\ max}$ $I_{TM} = 500 A, di/dt = 10 A/\mu s$ $V_R = 0,5 V_{RRM}, V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$	I_{RM}		130	A

Technische Information / Technical Information

eupec

Netz Thyristor
Phase Control Thyristor

T 201N 60...70TOH

N



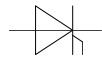
Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	beidseitig / two-sided, $\Theta = 180^\circ\text{sin}$ beidseitig / two-sided, DC Anode / anode DC Kathode / cathode DC	R_{thJC}	0,043 0,040 0,072 0.090	$^\circ\text{C/W}$ $^\circ\text{C/W}$ $^\circ\text{C/W}$ $^\circ\text{C/W}$
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	beidseitig / two-sided einseitig / single-sided	R_{thCH}	0,006 0,012	$^\circ\text{C/W}$ $^\circ\text{C/W}$
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur max. junction temperature		$t_{vj\text{ max}}$	125	$^\circ\text{C}$
Betriebstemperatur operating temperature		$t_{c\text{ op}}$	-40...+125	$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur storage temperature		t_{stg}	-40...+150	$^\circ\text{C}$

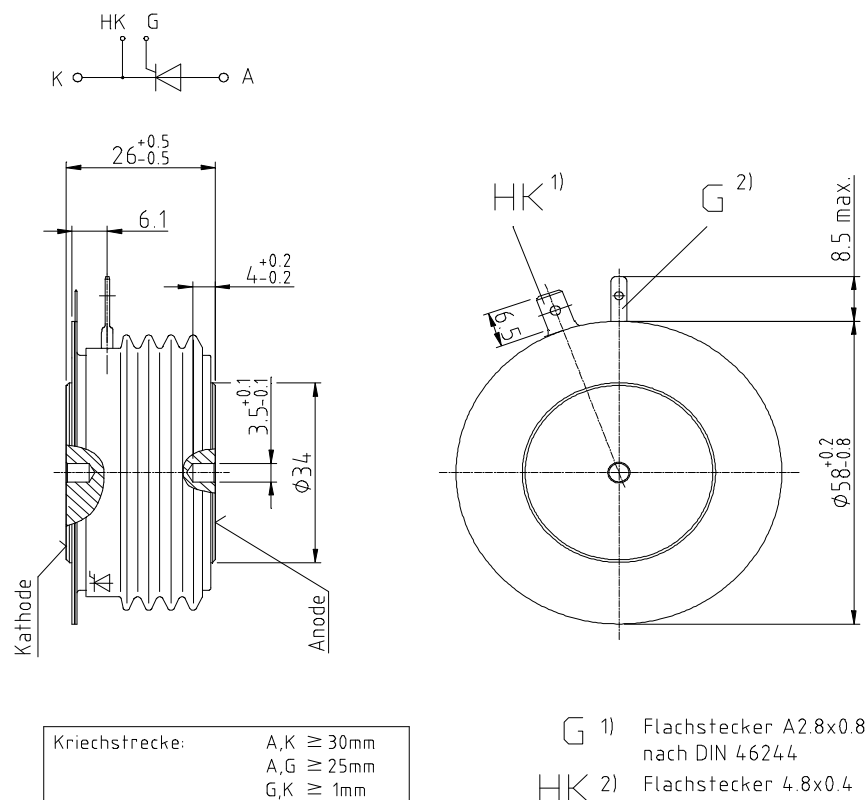
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

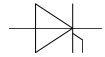
Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix			Seite 4	
Si-Element mit Druckkontakt, Amplifying-Gate Si-pellet with pressure contact, amplifying gate			38TN70	
Anpreßkraft clampig force		F	7...12	kN
Gewicht weight		G	typ. 250	g
Kriechstrecke creepage distance			25	mm
Feuchtekategorie humidity classification	DIN 40040		C	
Schwingfestigkeit vibration resistance	f = 50Hz		50	m/s^2

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.
This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.



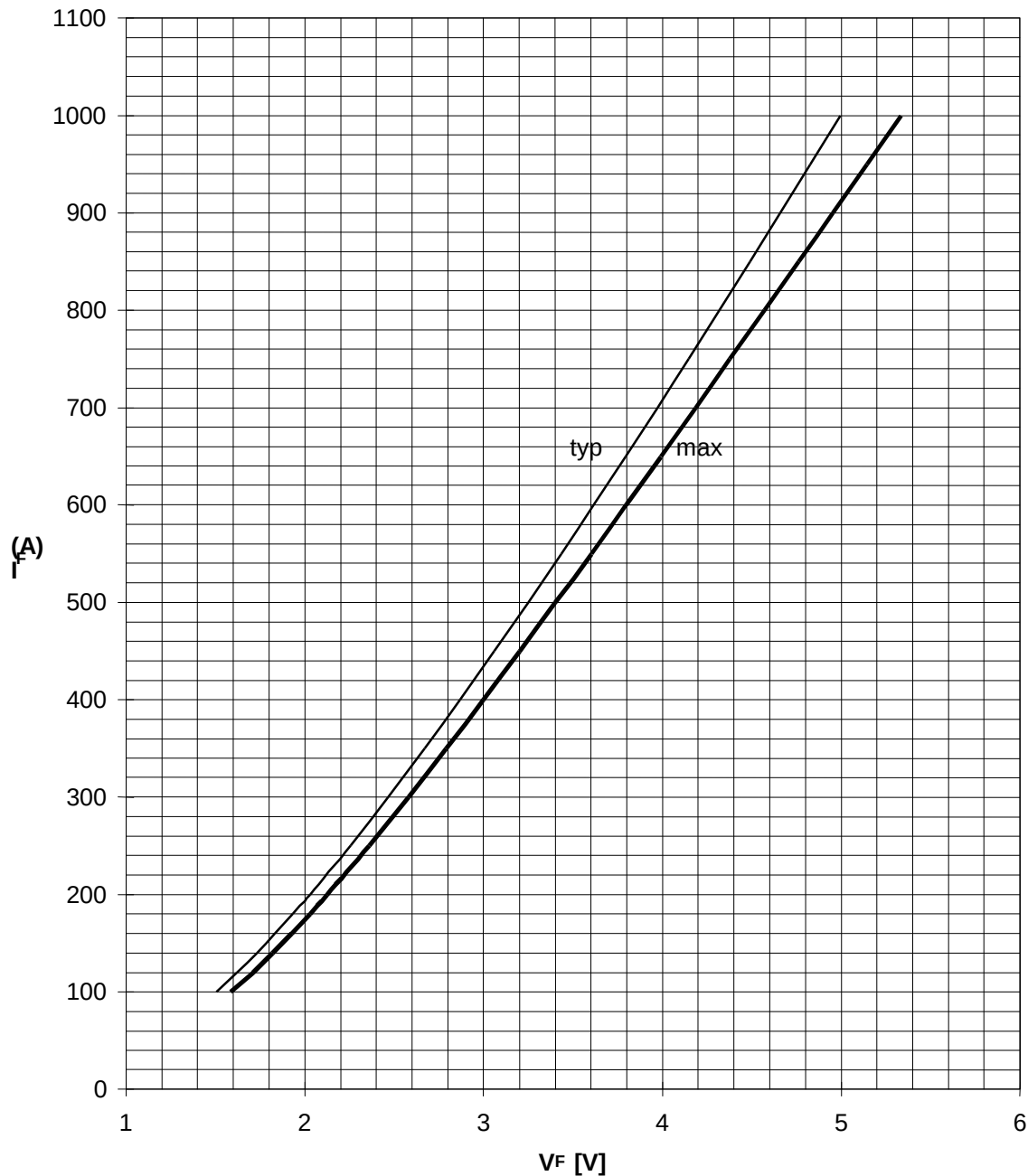
Maßbild / Outline

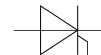




Durchlaßkennlinie $i_T = f(v_T)$
Limiting and typical on-state characteristic

$\frac{3}{4}$ $t_{vj} = 125^\circ\text{C}$



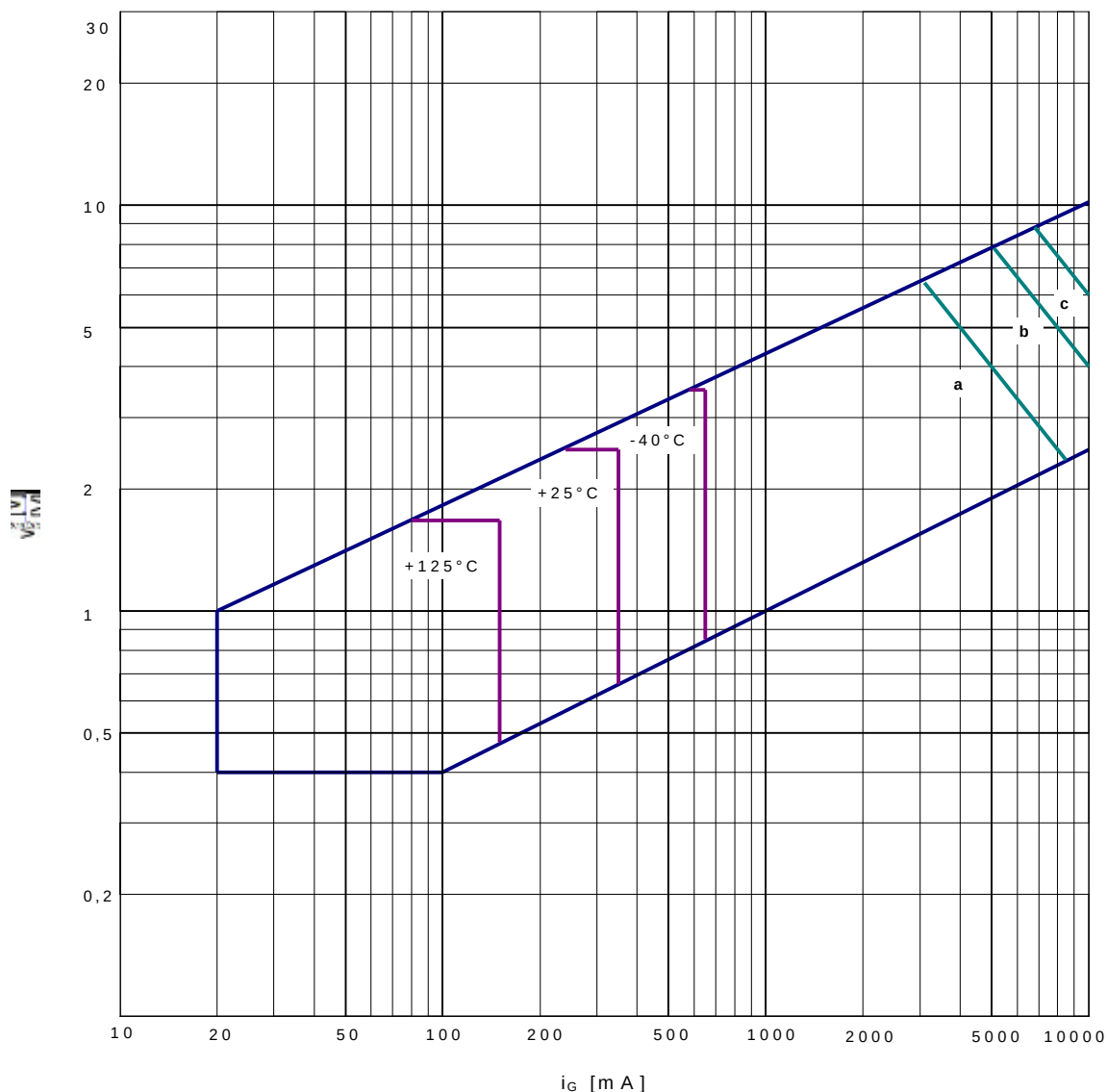


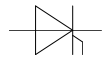
Steuerkreischarakteristik mit Zündbereichen

Gate characteristic with triggering areas

$$v_G = f(i_G), V_D = 6V$$

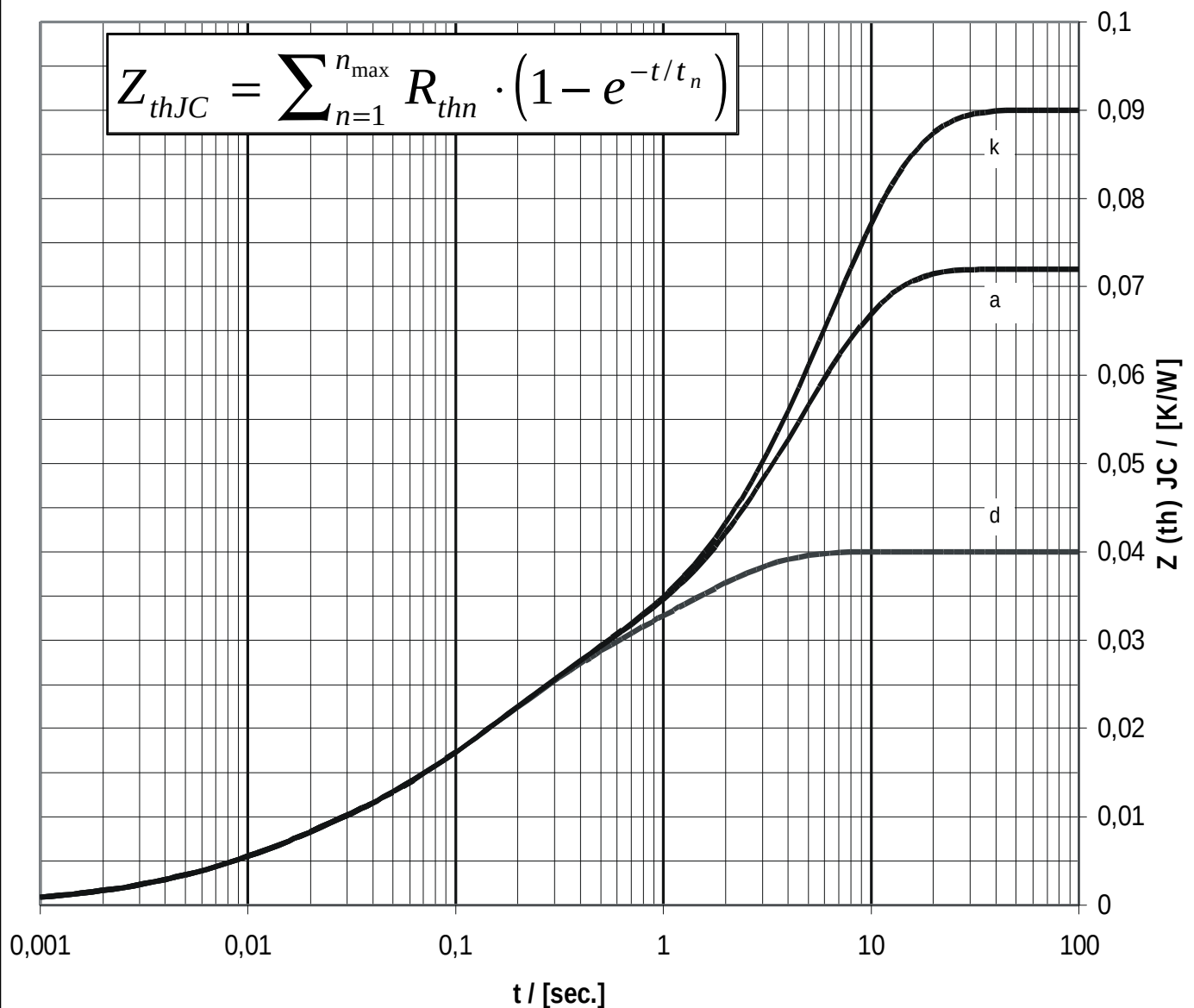
Parameter		a	b	c
Steuerimpulsdauer / trigger pulse duration	$t_G(\text{ms})$	10	1	0.5
Höchstzulässige Spitzensteuerverlustleistung				
Max. rated peak power dissipation	$P_{GM}(\text{W})$	20	40	60

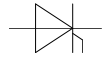




Transienter innerer Wärmewiderstand Transient thermal impedance $Z_{(th) JC} = f(t)$

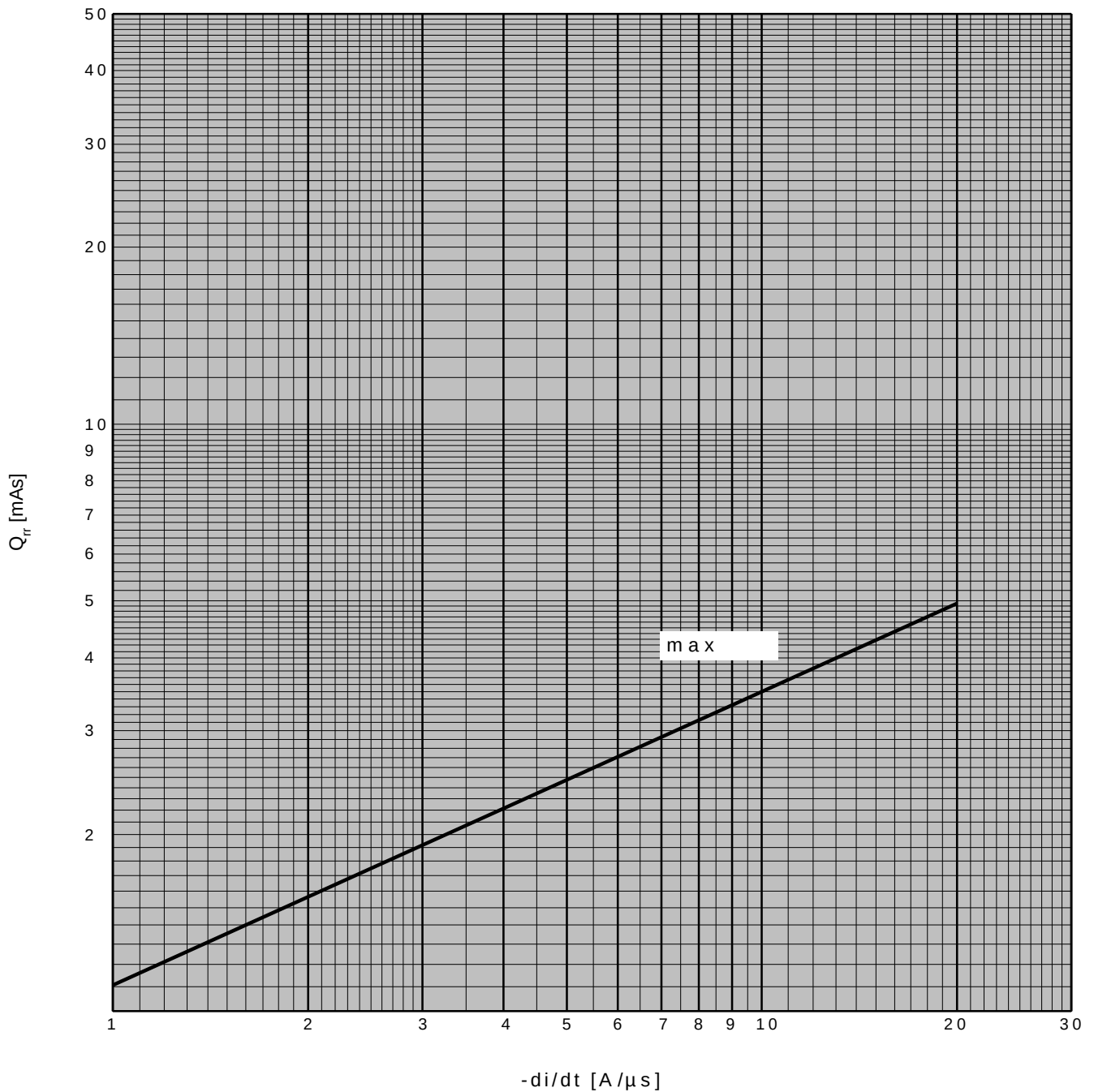
	doppelseitige Kühlung		anodenseitige Kühlung		kathodenseitige Kühlung	
	r [K/W]	[s]	r [K/W]	[s]	r [K/W]	[s]
1	0,0146	1,4	0,0466	4,5	0,0646	6,2
2	0,0126	0,2	0,0126	0,2	0,0126	0,2
3	0,0072	0,063	0,0072	0,063	0,0072	0,063
4	0,005	0,01	0,005	0,01	0,005	0,01
5	0,0006	0,002	0,0006	0,002	0,0006	0,002
	0,04	-	0,072	-	0,09	-

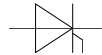




Sperrverzögerungsladung $Q_r = f(-di/dt)$ recovered charge

$t_{vj} = 125^\circ\text{C}$, $I_{TM} = 500\text{A}$,
 $V_R = 0,5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$



**Rückstromspitze / reverse recovery current**
(typische Abhängigkeit / typical dependence)

$$I_{RM} = f(di/dt)$$

$$t_{vj} = 125^{\circ}\text{C}, I_{TM} = 500\text{A}, v_R = 0,5 \cdot V_{RRM}, v_{RM} = 0,8 \cdot V_{RRM}$$

